

- [5] Л я м ш е в Л.М. - Успехи физ. наук., 1981, т. 135, № 4, с. 637.
- [6] К а г а н о в М.И., Ф и к с В.Б. - Успехи физ. наук, 1986, т. 150, № 1, с. 159.
- [7] Г р и г о р о в Л.Н. - Деп. в ВИНИТИ 5.08.87, № 5633-В 87.
- [8] Г р и г о р о в Л.Н. - Деп. в ВИНИТИ 5.08.87, № 5634-В 87.

Институт синтетических  
полимерных материалов  
АН СССР

Поступило в Редакцию  
17 марта 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 11 12 июня 1988 г.

## НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОПТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В АМОРФНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ

Г.П. Б е р м а н, В.А. С е р е д к и н,  
Г.И. Ф р о л о в, В.Ю. Я к о в ч у к

Пленки РЗМ-ПМ в настоящее время рассматриваются как перспективный материал для магнитооптической памяти [1-2]. В этих устройствах для записи и считывания информации используется лазерный луч. Принято считать, что запись производится термомагнитным способом: нагрев при постоянном подмагничивающем поле ( $H_0$ ) локальных участков среды до пороговых температур, когда  $H$  превышает значение коэрцитивной силы нагретых участков. Наиболее подробно описана в литературе и широко применяется на практике запись при температуре Кюри ( $T_C$ ) [2-3].

Нами были проведены исследования по регистрации на пленках  $R\text{-Fe}(R\text{-Tb}, Dy)$  световых импульсных излучений в широком диапазоне длин волн ( $\lambda = 0.34\text{--}10.6 \text{ мкм}$ ) при изменении длительности излучений от  $10^{-11}$  до  $10^{-3} \text{ с}$ . Были получены результаты, трудно объяснимые с позиций термомагнитного принципа записи (ТМЗ). Во-первых, при ТМЗ динамический диапазон регистрируемых энергий  $U_{max}/U_{min} \leq 3$  ( $U_{min}$  - минимальная энергия, которая может быть зарегистрирована в данных условиях;  $U_{max}$  - энергия, при которой наблюдаются необратимые изменения параметров материала) в нашем случае  $> 10$ . В качестве примера на рис. 1 приведен вид структуры пучка излучения импульсного лазера  $\text{CO}_2$  при различных уровнях энергии излучения. Регистрация осуществлялась на пленке  $Dy\text{Fe}$ . При изменении энергии излучения от  $U_{min} = 0.15 \cdot 10^{-3} \text{ Дж}$  до  $U_{max} = 10^{-2}$  плотность энергии в центре записанного участка возрастает более, чем в 10 раз. Если бы реализовался механизм ТМЗ, температура в центре участка должна была превы-

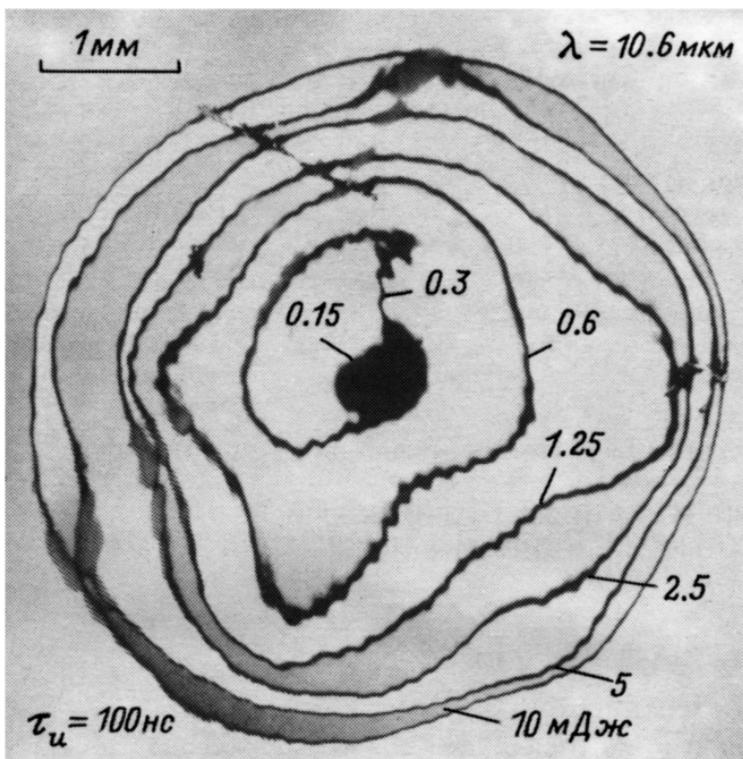


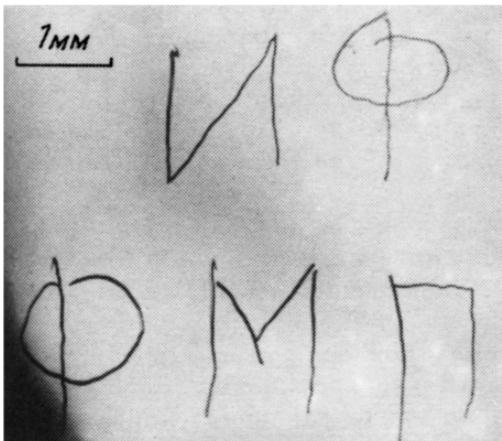
Рис. 1.

сить температуру испарения пленки. Во-вторых, при переходе от наносекундных импульсов к пикосекундным наблюдается значительное увеличение энергетической чувствительности — снижение  $U_{min}$ . При этом облученный участок нагревается до температуры  $T \ll T_c$ . Факт записи информации в этом случае также не может быть объяснен в рамках терромагнитного механизма.

Для объяснения этих результатов предложен другой механизм записи, учитывающий большую магнитострикцию в сплавах РЗМ-ПМ. В дальнейшем, по аналогии с терромагнитной записью, будем называть этот принцип упругомагнитным (УМЗ).

Пусть энергия лазерного пучка поглощается локальным участком пленки толщиной  $h/d_0$  ( $d_0$  — коэффициент поглощения света),  $D/h \gg 1$  ( $D$  — диаметр облучаемого участка). Если длительность лазерного импульса  $\tau$  достаточно мала, так что эффекты диффузии тепла не успевают проявиться, то вся поглощенная энергия идет на увеличение внутренней энергии  $U$  вещества локального участка. Будем считать, что за время  $\tau$  в облучаемом участке устанавливается состояние термодинамического равновесия, а возможное изменение размеров участка связано лишь с изменением  $h$  (оценки показывают, что оба

Рис. 2.



эти допущения являются оправданными). Основное термодинамическое тождество записывается в виде  $dU = TdS + \rho\sigma dh$  ( $\sigma = \frac{\partial U}{\partial h}$ ).

В качестве уравнения состояния воспользуемся обобщенным законом Гука:  $\rho = E \left\{ \frac{h}{h_0} [1 - \alpha(T - T_0)] - 1 \right\}$ , где:

$\alpha$  — коэффициент линейного температурного расширения,  $E$  — модуль Юнга,  $h_0 = h(T - T_0)$ ,  $\rho = \rho_0 = 0$ . Если за время импульса упругие деформации не успевают проявиться ( $\tau < h/C_s$ ), где  $C_s$  — скорость звука), то процесс поглощения лазерной энергии можно считать изохорическим ( $h = h_0 = \text{const}$ ). В этом случае имеем для изменения температуры  $\Delta T = T - T_0$  и давления  $P : \Delta T = \Delta U / \rho V C$ ,  $\rho = -E \alpha \Delta T$ . Выпишем также характеристические параметры для случая адиабатического процесса ( $S = \text{const}$ ), который может давать вклад при более длинных импульсах

$$(\tau \sim h/C_s) : \Delta T = (T_0 \alpha / \rho) \sqrt{\frac{E \Delta U}{V}} ; \rho = -\frac{\rho C_s \Delta T}{T_0 \alpha} \Delta h / h_0 = \rho C_s \Delta T / T_0 \alpha E ,$$

где  $\Delta U$  — передаваемая лазерным импульсом энергия;  $\rho$ ,  $C$ ,  $V$  — плотность, теплоемкость и объем облучаемого участка;  $\Delta h = h - h_0$ .

Приведем численные оценки изменения температуры и давления. Выбираем экспериментально реализуемые параметры; энергию  $\Delta U = 0.5 \cdot 10^{-11}$  Дж и длительность импульса  $\tau = 30 \cdot 10^{-12}$  с ( $h_0 = 10^{-5}$  см;  $D = 10^{-4}$  см;  $E = 3 \cdot 10^{11}$  Н/м<sup>2</sup>;  $\alpha = 10^{-5}$  град<sup>-1</sup>;  $\rho = 8$  г/см<sup>3</sup>;  $C = 400$  Дж/кг град). В этом случае для изохорического процесса имеем:  $\Delta T = 20^\circ$ ;  $\rho = -600$  кг/см<sup>2</sup>; для адиабатического:  $\Delta T = 4.1^\circ$ ;  $\rho = -4.3 \cdot 10^4$  кг/см<sup>2</sup>;  $\Delta h / h_0 = -1.3 \cdot 10^{-2}$ . Как видно, в обоих случаях и развивается давление сжатия.

Оценим достаточно ли величины этих давлений для перемагничивания покальных участков. Для магнитострикционного материала можно записать:  $U = -\lambda_s P$ , где  $U$  — магнитоупругая энергия, вызванная давлением  $P$ ,  $\lambda_s$  — коэффициент магнитострикции. Чтобы перемагнитить участок,  $U$  должна быть сравнима с энергией одноосной магнитной анизотропии  $K_u$ , т. е. необходимое давление  $P \approx K_u / \lambda_s$ . Для аморфных пленок  $DyFe$   $K_u \approx 10^5$  Эрг/см<sup>3</sup>,  $\lambda_s = 10^{-4}$  [4]. Тогда  $P \approx 10^3$  кг/см<sup>3</sup>. Таким образом, при облучении покального участка коротким импульсом оптического излучения можно практически без нагрева получить в нем давления, достаточные для компенсации

энергии магнитной анизотропии. Если поместить этот участок в небольшое подмагничивающее поле  $H_0$ , то произойдет его перемагничивание.

Из предложенной модели вытекают следующие два вывода.

1. Запись информации на пленках РЗМ-ПМ можно проводить при постоянной температуре, накладывая на них определенное статическое давление.

2. В диапазоне длительностей импульсов световых излучений  $\tau$  от  $10^{-7}$  до  $10^{-10}$  с энергетическая чувствительность среды  $U_{min}$  будет тем выше, чем короче излучение:  $U_{min}(\tau) \propto \tau$ ; в области  $\tau \leq 10^{-11}$  с.

Эти выводы были проверены. Как показано выше, для перемагничивания локального участка пленки необходимо приложить давление  $P \propto 10^3$  кг/см<sup>2</sup>. Примерно такие давления развиваются при письме твердым карандашом. На рис. 2 представлен пример записи немагнитным наконечником на пленке  $TbFe$ .

При изменении длительности лазерного импульса нами были получены следующие энергетические чувствительности:  $\tau = 10^{-7}$  с ( $\lambda = 10.6$  мкм),  $U_{min} = 2 \cdot 10^{-2}$  Дж/см<sup>2</sup>;  $\tau = 2 \cdot 10^{-8}$  с ( $\lambda = 0.34$  мкм),  $U_{min} = 3 \cdot 10^{-3}$  Дж/см<sup>2</sup>;  $\tau = 3 \cdot 10^{-11}$  с ( $\lambda = 0.53$  мкм),  $U_{min} = 4 \cdot 10^{-4}$  Дж/см<sup>2</sup>.

Последнее значение  $U_{min}$  близко к асимптотическому.

В заключение отметим, что использование явления УМЗ расширяет функциональные возможности устройств оптической памяти на пленках РЗМ-ПМ, т. к. при этом значительно сокращается время цикла запись-стирание.

Авторы выражают благодарность М.Ш. Ерухимову за полезные дискуссии.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] White R.W. - J. Appl. Phys., 1985, v. 57 (1), p. 2996.
- [2] Майкепсои У.М. - ТИИЭР, 1986, v. 74, p. 112.
- [3] Shinn S.C. - J. ZM, 1986, v. 61, p. 301.
- [4] Clark A.E. Handbook of the physics and chemistry of rare earths, - Norbt-Holland Publishing Company, 1979, ch 15, p. 231.

Институт физики им. Л.В. Киренского  
СО АН СССР, Красноярск

Поступило в Редакцию  
21 декабря 1987 г.